



*Рис. 1.* Спектры электролюминесценции структур  $\text{SiO}_2/\text{Si}$ , полученных методами термического окисления (*а*) и плазмохимического осаждения (*б*).

Плотность тока через образец составляла 150 и 250  $\mu\text{A}/\text{cm}^2$  соответственно.

На рисунке *б* дополнительно показан спектр отражения

*Fig. 1.* Electroluminescence spectra of the  $\text{SiO}_2/\text{Si}$  structures formed by thermal oxidation (*a*) and plasma-enhanced chemical vapor deposition (*b*).

The current density through the sample was 150 and 250  $\mu\text{A}/\text{cm}^2$ , respectively.

Figure *b* additionally shows a reflectance spectrum